



# 南京大学 电子科学与工程学院

## School of Electronic Science and Engineering

### 论坛快速入口

用户名:

密 码:

[首 页](#) [本院概貌](#) [最新动态](#) [机构设置](#) [学科介绍](#) [师资队伍](#) [人才培养](#) [教学成果奖](#) [科学研究](#) [学生园地](#) [刘斌助学基金](#) [信息交流](#) [学校OA](#) [网站地图](#)

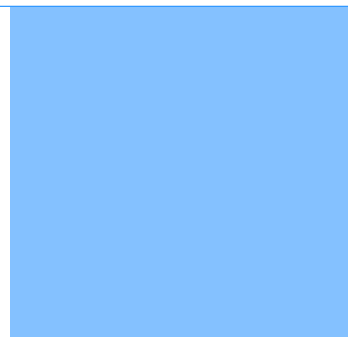
## 南京大学-电子学院-教师简介-陈敦军

陈敦军 [English Version](#)

陈敦军

男, 1969.10, 博导, 教授

**个人简历:** 1987-2001年就读于西北工业大学材料科学与工程系, 并获博士学位, 现为南京大学电子科学与工程学院教授、博士生导师。2006年-2007年受哈佛大学GSAS资助在其工程与应用科学学院做邀请访问学者。2005年入选“教育部新世纪优秀人才计划”, 2008年被评为南京大学中青年优秀学术带头人。



**研究方向：** 目前主要从事GaN基光电子探测器/传感器结构设计与器件工艺和物理、GaN基太阳能电池材料与器件结构设计及器件制备、GaN基异质结构设计与表征及其微波功率器件可靠性、新型低维半导体结构与器件等方面的研究。

**主要课程：**

低维半导体物理与器件

**代表成果：**

1. D. J. Chen, B. Liu, H. Lu, Z. L. Xie, R. Zhang, Y. D. Zheng, Improved performances of InGaN schottky photodetectors by inducing a thin insulator layer and mesa process, IEEE Electron Device Lett. 30: 605 (2009).
2. D. J. Chen, J. J. Xue, B. Liu, H. Lu, Z. L. Xie, P. Han, R. Zhang, Y. D. Zheng, Observation of hole accumulation at the interface of an undoped InGaN/GaN heterostructure, Appl. Phys. Lett. 95: 012112 (2009).
3. D. J. Chen, Y. Q. Tao, C. Chen, B. Shen, R. Zhang, Y. D. Zheng, Z. H. Li, G. Jiao, T. S. Chen, Improved transport properties of the two-dimensional electron gas in AlGaIn/GaN heterostructures by AlN surface passivation layer. Appl. Phys. Lett. 89: 252104 (2006).
4. D. J. Chen, B. Shen, X. S. Wu, R. Zhang, Y. D. Zheng, High-temperature characteristics of strain in  $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}/\text{GaN}$  heterostructures with and without  $\text{Si}_3\text{N}_4$  passivation layer, Appl. Phys. Lett. 88: 102106 (2006).
5. Y. Huang, D. J. Chen\*, H. Lu, P. Han, R. Zhang, Y. D. Zheng, Photocurrent Characteristics of Two Dimensional Electron Gas Based AlGaIn/GaN Metal-Semiconductor-Metal Photodetectors, Appl. Phys. Lett. 96:243503 (2010).

电话：025-83685372

邮件：djchen@nju.edu.cn

信箱：南京大学电子科学与工程学院

办公地址：蒙民伟楼807

[>>> 返回](#)